TR2002SF

Rectifier Diode

APPLICATIONS

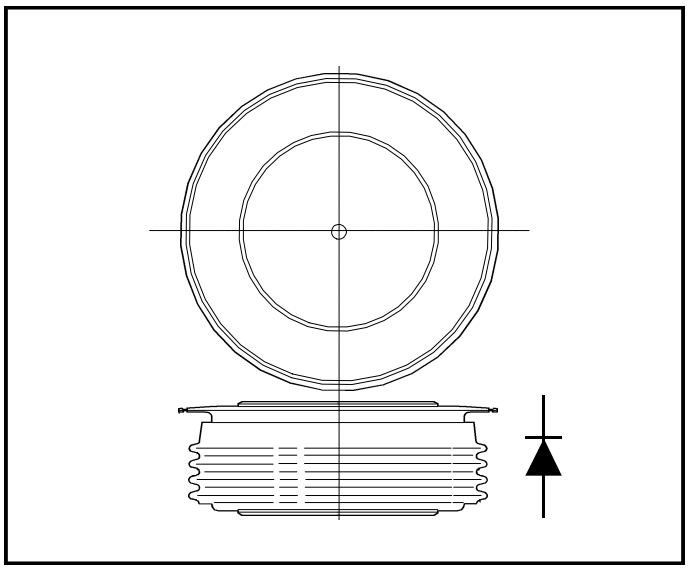
- Rectification.
- Freewheel Diode.
- DC Motor Control.
- Power Supplies.
- Welding.
- Battery Chargers.

KEY PARAMETERS

V_{RRM}	1800V
$I_{F(AV)}$	2320A
I_{FSM}	41250A

FEATURES

- Double Side Cooling.
- High Surge Capability.



Outline type code: F
See Package Details for further information.

VOLTAGE RATINGS

Type Number	Repetitive Peak Reverse Voltage V_{RRM} V	Conditions
TR2002SF18	1800	$V_{RSM} = V_{RRM} + 100V$
TR2002SF17	1700	
TR2002SF16	1600	
TR2002SF15	1500	
TR2002SF14	1400	
TR2002SF13	1300	

Lower voltage grades available.

CURRENT RATINGS

Symbol	Parameter	Conditions	Max.	Units
Double Side Cooled				
$I_{F(AV)}$	Mean forward current	Half wave resistive load, T_{case} = 100°C	2320	A
$I_{F(RMS)}$	RMS value	T_{case} = 100°C	3644	A
I_F	Continuous (direct) forward current	T_{case} = 100°C	3300	A
Single Side Cooled (Anode side)				
$I_{F(AV)}$	Mean forward current	Half wave resistive load, T_{case} = 100°C	1345	A
$I_{F(RMS)}$	RMS value	T_{case} = 100°C	2110	A
I_F	Continuous (direct) forward current	T_{case} = 100°C	1630	A

SURGE RATINGS

Symbol	Parameter	Conditions	Max.	Units
I_{FSM}	Surge (non-repetitive) forward current	10ms half sine; T_{case} = 175°C	33.0	kA
I^2t	I^2t for fusing	V_R = 50% V_{RRM} - 1/4 sine	5.44 x 10^6	A^2s
I_{FSM}	Surge (non-repetitive) forward current	10ms half sine; T_{case} = 175°C	41.25	kA
I^2t	I^2t for fusing	V_R = 0	8.5 x 10^6	A^2s

THERMAL AND MECHANICAL DATA

Symbol	Parameter	Conditions		Min.	Max.	Units
$R_{th(j-c)}$	Thermal resistance - junction to case	Double side cooled	dc	-	0.022	°C/W
		Single side cooled	Anode dc	-	0.038	°C/W
			Cathode dc	-	0.052	°C/W
$R_{th(c-h)}$	Thermal resistance - case to heatsink	Clamping force 19.5kN with mounting compound	Double side	-	0.004	°C/W
			Single side	-	0.008	°C/W
T_{vj}	Virtual junction temperature	Forward (conducting)		-	185	°C
		Reverse (blocking)		-	175	°C
T_{stg}	Storage temperature range			-55	200	°C
-	Clamping force			18.0	22.0	kN

CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Max.	Units
V_{FM}	Forward voltage	At 3400A peak, T_{case} = 25°C	-	1.18	V
I_{RRM}	Peak reverse current	At V_{RRM}, T_{case} = 175°C	-	50	mA
Q_S	Total stored charge	I_F = 2000A, dI_{RR}/dt = 3A/µs	-	1500	µC
I_{RR}	Peak recovery current	T_{case} = 175C, V_R = 100V	-	90	A
V_{TO}	Threshold voltage	At T_{vj} = 175C	-	0.74	V
r_T	Slope resistance	At T_{vj} = 175C	-	0.088	mΩ

CURVES

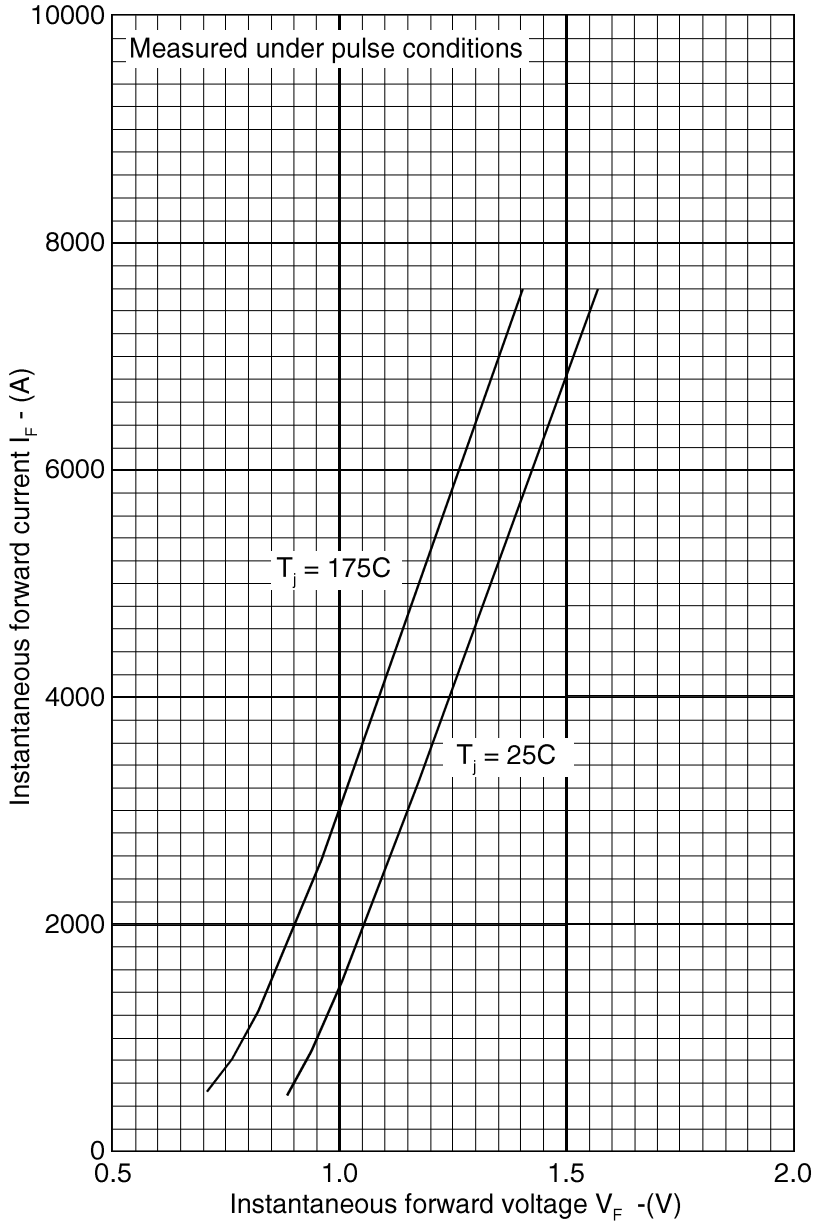


Fig.1 Maximum (limit) forward characteristics

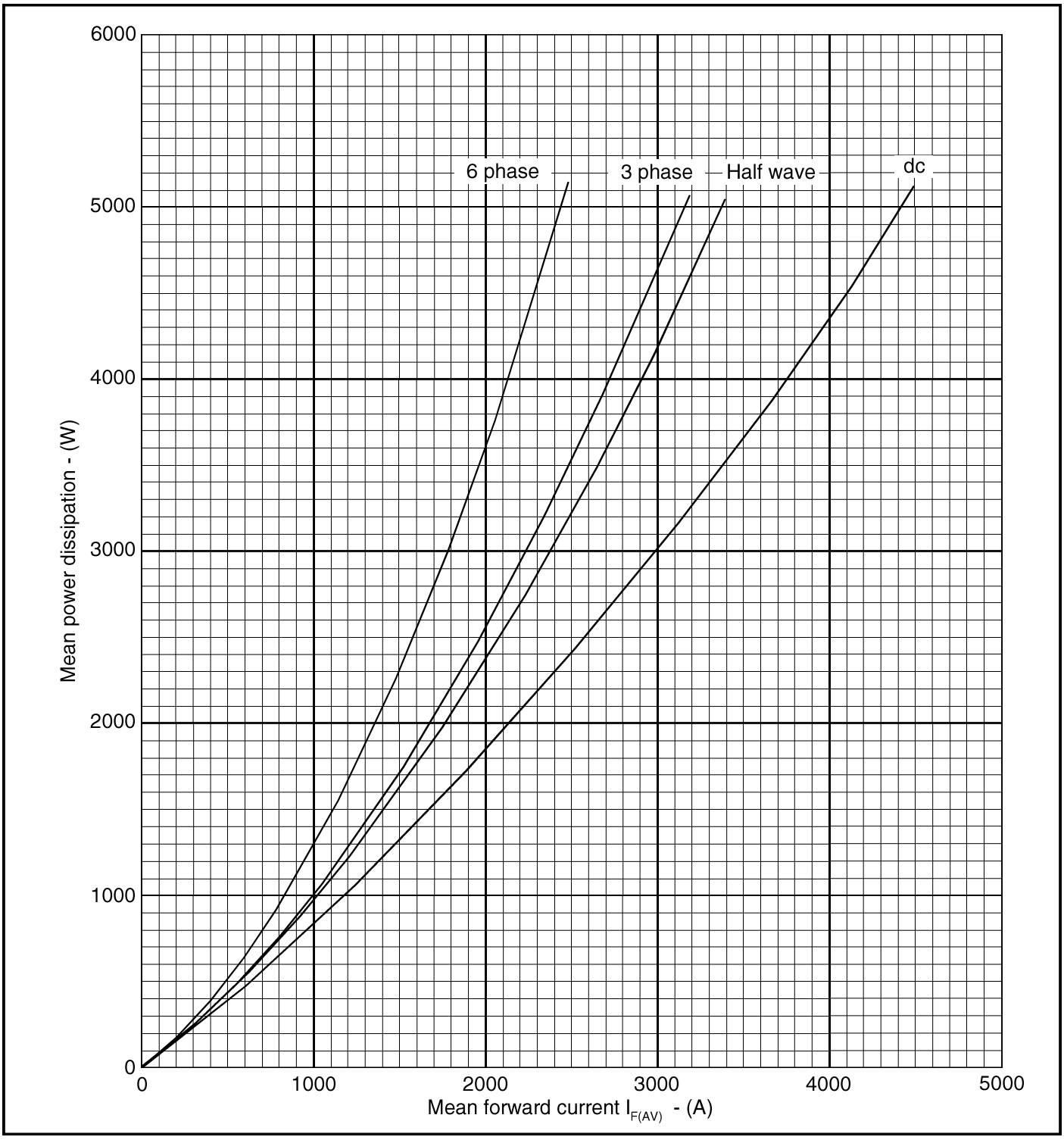


Fig.2 Dissipation curves

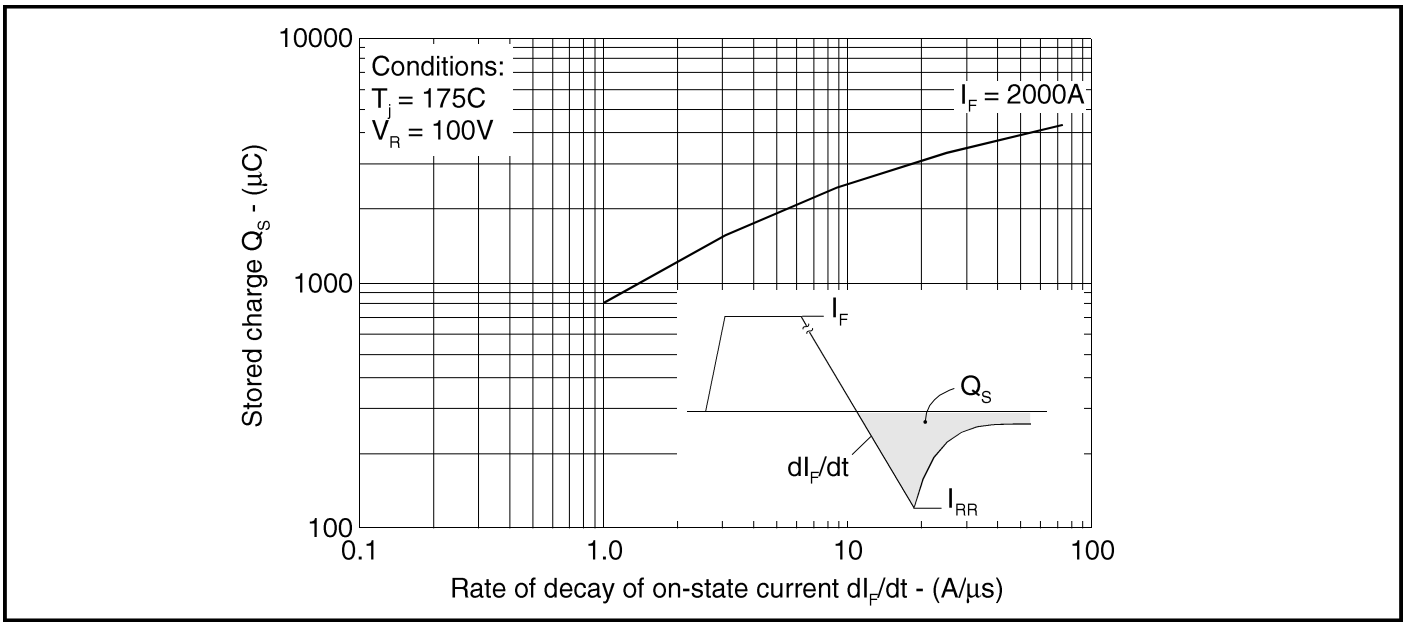


Fig.3 Maximum total stored charge

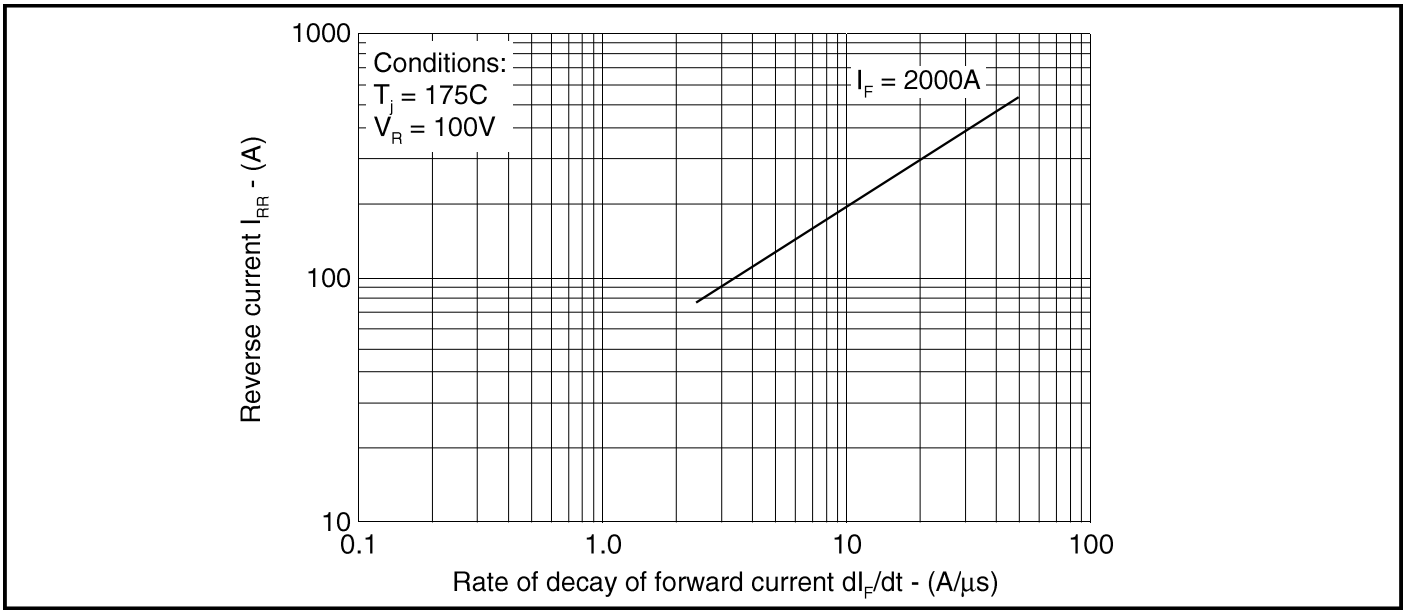


Fig. 4 Maximum reverse recovery current

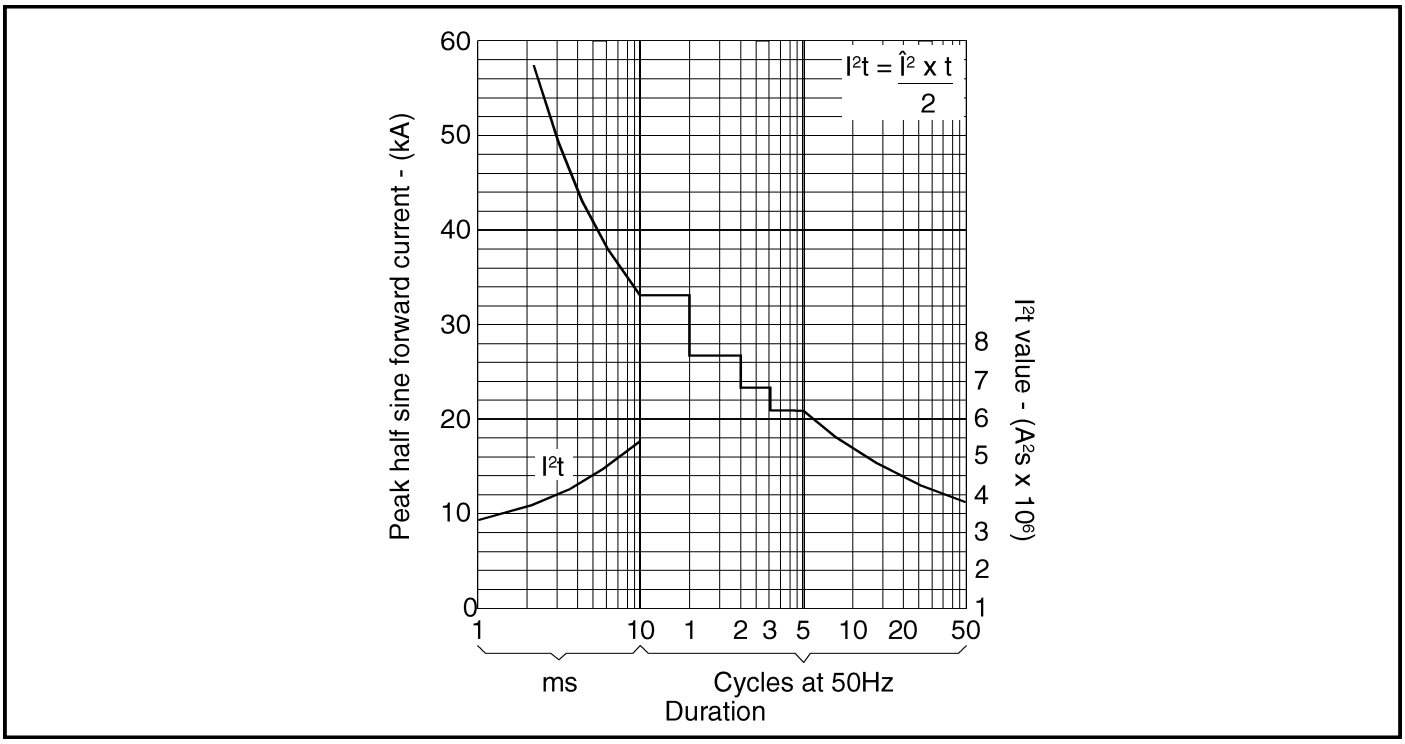
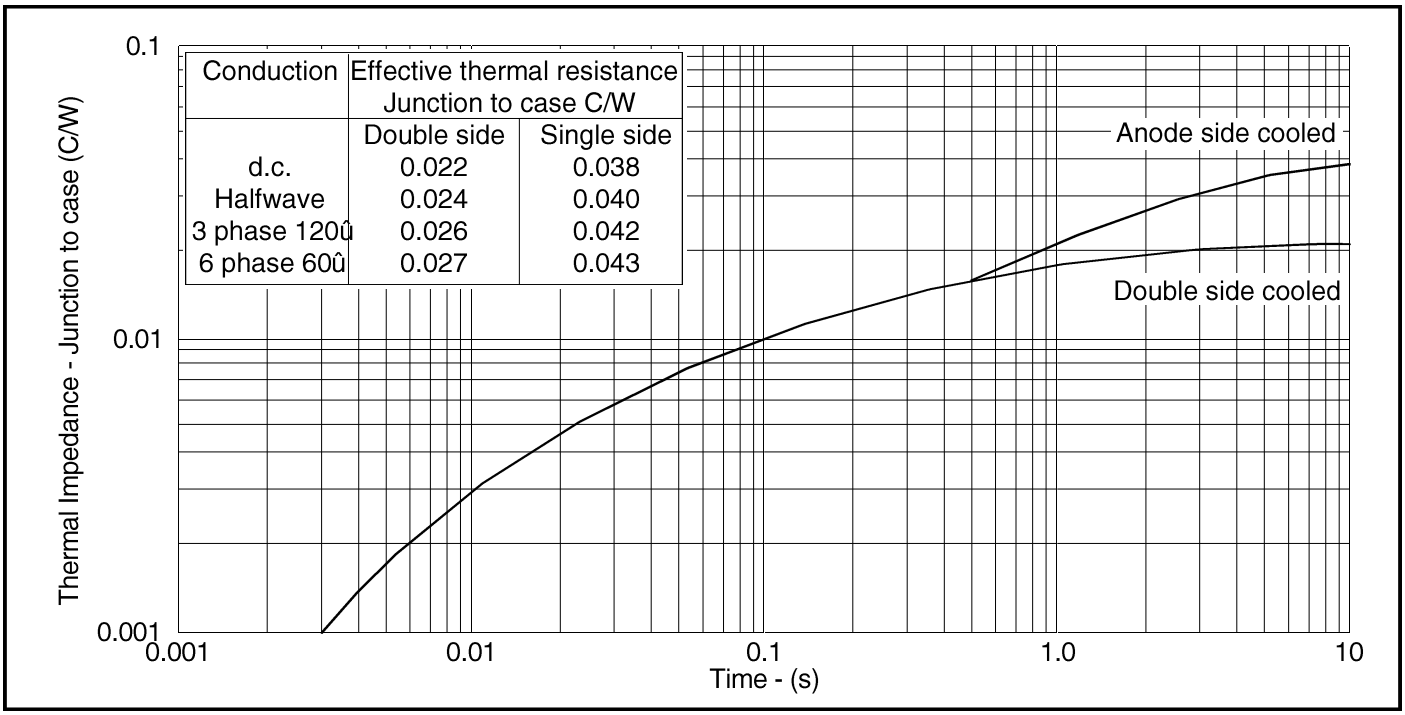


Fig. 5 Surge (non-repetitive) forward current vs time (with 50% V_{RRM}, T_{case} = 175C)

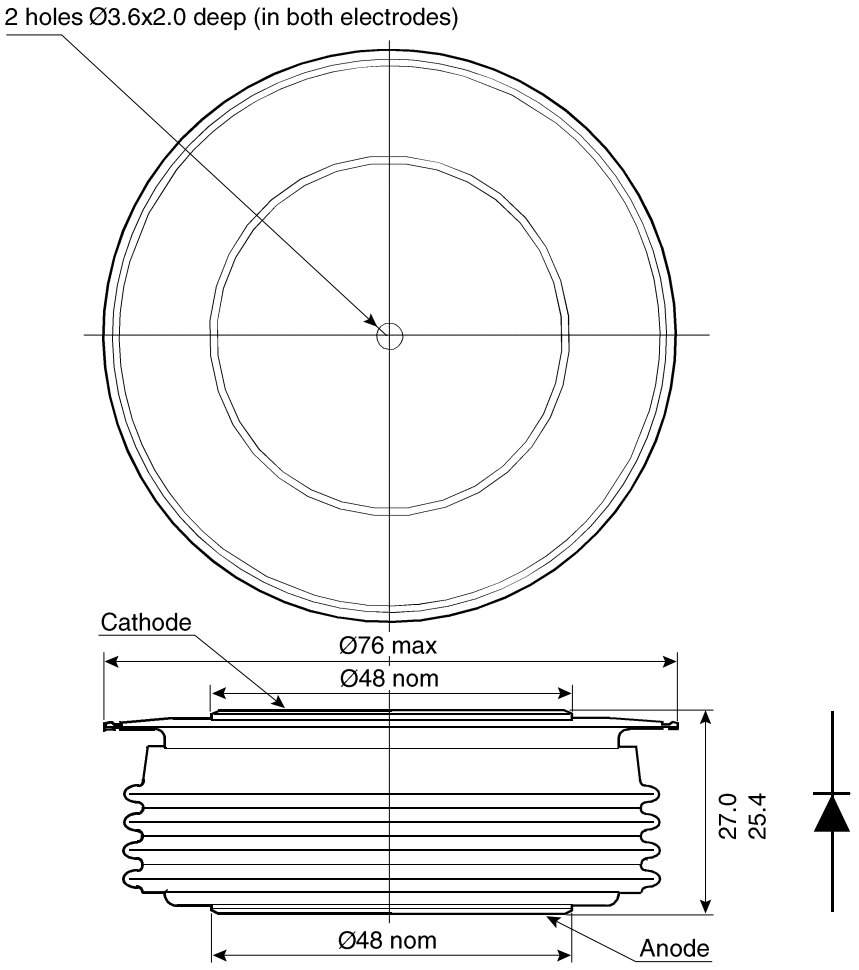


Conduction	Effective thermal resistance Junction to case C/W	
	Double side	Single side
d.c.	0.022	0.038
Halfwave	0.024	0.040
3 phase 120û	0.026	0.042
6 phase 60û	0.027	0.043

Fig. 6 Transient thermal impedance - junction to case - (C/W)

PACKAGE DETAILS

For further package information, please contact your local Customer Service Centre. All dimensions in mm, unless stated otherwise. DO NOT SCALE.



Nominal weight: 500g
Clamping force: 19.6kN ± 10%

Package outline type code: F

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9